

Silicon Diode

BA175

50V / 250mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1972/73

BA 175

Nicht für Neuentwicklungen

Silizium-Epitaxial-Planar-Universal-Diode für Siebdruckschaltungen.

Silicon epitaxial planar diode for general purpose. Used for hybrid circuits.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm

M 2:1



Kunststoffgehäuse
DOM 22
Gewicht · Weight
max. 0,01 g

Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Sperrspannung	U_R	50	V
Spitzensperrspannung	U_{RM}	75	V
Richtstrom	I_O	200	mA
Durchlaßstrom	I_F	250	mA
Spitzendurchlaßstrom	I_{FM}	600	mA
Stoßdurchlaßstrom	i_{FM}	3	A
$t_p \leq 1 \mu s$			
Verlustleistung	$P_V^{1)}$	62	mW
$t_{amb} \leq 25^\circ C$			
Sperrschichttemperatur	t_j	125	$^\circ C$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-55...+125	$^\circ C$

¹⁾ In einem vergossenen Modul wird die zulässige Verlustleistung größer und muß von Fall zu Fall bestimmt werden.
In a sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked.

BA 175

		Min.	Typ.	Max.
Wärmewiderstand · Thermal resistance				
Sperrschicht-Umgebung	R_{thJA}			1,6 °C/mW
Kenngrößen · Characteristics				
Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}C$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 100\text{ mA}$	$U_F^{1)}$		1	V
Sperrstrom				
$U_R = 50\text{ V}$	I_R		100	nA
$U_R = 50\text{ V}, t_{amb} = 125^{\circ}C$	I_R		100	μA
Durchbruchspannung				
$I_R = 100\ \mu A$	$U_{(BR)}$	75		V
Diodenkapazität				
$U_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_D		8	pF
Rückwärtserholzeit				
$I_F = 10\text{ mA}, U_R = 6\text{ V}$	t_{rr}		300	ns
$i_R = 1\text{ mA}, R_L = 100\ \Omega$				

1) $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3\text{ ms}$